9. Obliczyć koncentrację n swobodnych nośników ładunku oraz jej niepewność.		
Dane	Wartość	
d	$2\mu m$ [ $\mu m$ ]	
е	$1.602 * 10^{-19}$ [C]	
$\gamma_B$	353.2944756 [mV/mA*mT]	
<i>u</i> ( <i>d</i> )	0.1 [ <i>µm</i> ]	
$u_c(\gamma_B)$	34 [mV/mA*mT]	

$$n = \frac{1}{e\gamma_B d} = \frac{1}{1.602*10^{-19}*353.2944756*2} = \frac{1}{1.602*10^{-19}*706.5889512} = 8.83427E+15[1/(\mu m^3)]$$

$$\frac{dn}{d\gamma_B} = -\frac{1}{e\gamma_B^2 d} = -\frac{1}{1.602*10^{-19}*124816.9865*2} = -2.50054E+13$$

$$\left(\frac{dn}{d\gamma_B}\right)^2 = (-2.50054E+13)^2 = 6.2527E+26$$

$$\frac{dn}{dd} = -\frac{1}{e\gamma_B d^2} = -\frac{1}{1.602*10^{-19}*353.2944756*4} = -4.41713E+15$$

$$(\frac{dn}{dd})^2 = (-4.41713E+15)^2 = 1.9511E+31$$

$$(u(\gamma_B))^2 = (34)^2 = 1156$$
  $(u(d))^2 = (0.1)^2 = 0.01$ 

$$u_c(n) = \sqrt{(\frac{dn}{d\gamma_B}u(\gamma_B))^2 + (\frac{dn}{dd}u(d))^2} = \sqrt{1156*6.2527E+26+0.01*1.9511E+31} = \sqrt{7.23E+29+1.95E+29} = \sqrt{9.18E+29} = 9.58083E+14[1/(\mu m^3)]$$

10. Uzyskane wartości parametrów gammaB i n porównać z danymi literaturowymi oraz określić rodzaj materiału, z którego wykonany był badany hallotron.

Hallotron zosta wytworzony z półprzewodnika.